

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶表示装置およびその製造方法

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

JC862 U.S. PRO
09/852077
05/09/01

- 5 この発明は、薄膜トランジスタ（TFT）をマトリクス状に配置し、これをスイッチング素子として用いたアクティブマトリクス形の液晶表示装置およびその製造方法に関する。

【従来の技術】

- ガラス基板上に薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor：以下“TFT”と略す）をマトリクス状に形成し、これをスイッチング素子として用いるアクティブマトリクス型液晶表示装置は、高画質の平面ディスプレイとして開発されている。

- 従来広く使用されているねじれネマティック（twisted nematic；以下“TN”と略記する）型のアクティブマトリクス型液晶表示装置においては、液晶層を駆動する電極は、2枚のガラス基板上に形成して対向させた透明な電極を用いるようにし、電圧印加時の液晶分子が基板表面に平行になっている「白」表示状態から、印加電圧に応じて液晶分子が電界方向に配向ベクトルの向きを変化させていくことにより、「白」表示状態から次第に「黒」表示としている。

しかし、この電圧印加の液晶分子の特有の挙動により、TN型液晶表示装置の視野角が狭いという問題がある。この視野角が狭いという問題は、中間調表示における液晶分子の立ち上がり方向において特に著しい。

- 20 その、液晶表示装置の視角特性を改善する方法として、特開平4-261522号公報または、特開平6-43461号公報に開示されているような技術が提案されている。これらの技術では、ホメオトロピック配向させた液晶セルを作成し、偏光軸が直交するように設置した2枚の偏光板の間に挟み、その公報の図に示されているように、開口部を有する共通電極を使用することにより、各画素内に斜め電界を発生させ、これにより各画素を2個以上の液晶ドメインとし、視角特性を改善している。特開平4-261522号公報では特に、電圧を印加したときに液晶が傾く方向を制御することによって、高コントラストを実現している。

また、特開平6-43461号公報に記載されているように、必要に応じて光学補償板を使用し、黒の視角特性を改善している。さらに、特開平6-43461号公報においては、ホメオトロピック配向させた液晶セルのみならず、TN配向させたセルにおいても、斜め電

界により各画素を2個以上のドメインに分割し、視角特性を改善している。

また、公表特許平5-505247号公報に、液晶分子を基板と水平方向に保ったまま回転させるため、2つの電極を共に片方の基板上に設けるようにし、この2つの電極間に電圧をかけて、基板と水平方向の電界を生じさせるようにしたIPS (In-Plane-Switching) 方式の液晶表示装置が提案されている。この方式では、電圧を印加したときに液晶分子の長軸が基板に対して立ち上がることはない。このため視角方向を変えたときの液晶の複屈折の変化が小さく、視野角が広いという特徴がある。

このように、2つの電極をとともに片方の基板上に設けるようにしたIPS方式のアクティブマトリクス型液晶表示装置に関して、以下に説明する。このIPS方式のTFT液晶表示装置は、図12に示すように構成されている。なお、図12において、図12(a)は、図12(b)の平面図のAA'線の断面を示している。

まず、ガラス基板1201上にCrよりなるゲート電極1202および共通電極1203が形成され、これらの電極を覆うように窒化シリコンからなるゲート絶縁膜1204が形成されている。また、ゲート電極1202上には、ゲート絶縁膜1204を介して非晶質シリコンからなる半導体膜1205が形成され、トランジスタの能動層として機能するようになされている。

また、半導体膜1205のパターンの一部に重畳するようにモリブデンよりなるドレイン電極1206、ソース電極1207が形成され、これら全てを被覆するように窒化シリコンよりなる保護膜1208が形成されている。

また、図12(b)に示すように、ソース電極1207と引き出されている共通電極1203との間に1画素の領域が配置されることになる。

そして、以上のように構成した単位画素をマトリクス状に配置したアクティブマトリクス基板の表面には、配向膜ORI1が形成されている。この配向膜ORI1表面はラビング処理されている。

一方、ガラスよりなる対向基板1231には、カラーフィルター層1232が遮光部1233で区切られて形成され、これらの上に保護膜1234が形成されている。そして、この保護膜1234表面にも、配向膜ORI2が形成され、この配向膜ORI2表面もラビング処理されている。

そして、ガラス基板 1 2 0 1 と対向基板 1 2 3 1 が、配向膜 O R I 1 および配向膜 O R I 2 形成面で対向配置され、これらの間に液晶組成物 1 2 4 0 が配置されている。また、ガラス基板 1 2 0 1 および対向基板 1 2 3 1 の外側の面には、偏光板 1 2 5 1 が形成されている。なお、カラーフィルター層 1 2 3 2 を区切っている遮光部 1 2 3 3 は、その一部の領域が半
5 導体膜 1 2 0 5 よりなる薄膜トランジスタ上に配置するように形成されている。

以上のように構成されたアクティブマトリクス型液晶表示装置では、液晶組成物 1 2 4 0 に電界がかかっていないときは、液晶分子 1 2 4 1 a はそれら電極の延在方向におおよそ平行な状態となっており、ホモジニアス配向している。すなわち、液晶分子 1 2 4 1 a の長軸（光学軸）の方向と、ソース電極 1 2 0 7 と引き出されている共通電極 1 2 0 3 との間に形成される電界方向とのなす角度が、 45° 以上 90° 未満となるように、液晶分子 1 2 4
10 1 a は配向されている。なお、対向配置されているガラス基板 1 2 0 1 と対向基板 1 2 3 1 と、液晶分子 1 2 4 1 a との配向は、互いに平行となっている。また、液晶分子 1 2 4 1 a の誘電異方性は正とした。

ここで、ゲート電極 1 2 0 2 に電圧を印加して薄膜トランジスタ (T F T) をオンにすると、ソース電極 1 2 0 7 に電圧が印加されてソース電極 1 2 0 7 とこれに対向配置している
15 共通電極 1 2 0 3 の間に電界が誘起される。そして、この電界により、液晶分子 1 2 4 1 a は液晶分子 1 2 4 1 b へと向きを変える。この液晶分子 1 2 4 1 b は、ソース電極 1 2 0 7 とこれに対向配置している共通電極 1 2 0 3 の間に形成される電界の方向に、ほぼ平行な状態となる。そして、偏光板 1 2 5 1 の変更透過軸を所定角度に配置しておくことで、上述した液晶分子の動きによって光の透過率を変化させることができる。
20

このように、この I P S 方式のアクティブマトリクス型液晶表示装置では、透明電極がなくてもコントラストを与えることができる。そして、上述した I P S 方式のアクティブマトリクス型液晶表示装置では、液晶分子の長軸は基板平面とほぼ平行であり、電圧を印加することで立ち上がることがない。このため、視角方向を変えたときの明るさの変化が小さく、
25 視覚特性が大幅に改善されるという効果を有している。

さらに、文献 (Journal of Applied Physics, Vol. 45, No. 12 (1974) 5466) または、特開平 1 0 - 1 8 6 3 5 1 号公報には、上記の I P S モードの他に誘電率異方性が正の液晶を基板に対して垂直にホメオトロピック配向させておき、基板に水平方向の電界で液晶分子を基板と水平方向に倒す方式が述べられている。このとき、電界の方向のためホメオトロピック配向さ

せた液晶分子は傾く方向が異なる2つ以上の領域に分かれる。

しかしながら、IPS方式においては、従来では、液晶が配置される層と対向基板との間にカラーフィルターの層が配置されていたため、ソース電極と引き出されている共通電極との間に電位を印加することで形成される電界が、カラーフィルターの層に影響を及ぼし、アクティブマトリクス型液晶表示装置の表示の特性を悪化させるという問題があった。

すなわち、カラーフィルター層を構成する色素には、不純物としてナトリウムイオンなどが含まれているため、カラーフィルターの層に電界がかかると、そこに電荷がたまってチャージアップすることになる。そして、カラーフィルターの層がチャージアップすると、その箇所の下部の液晶に不要な電界がいつでもかかっている状態となるため、表示特性に影響を及ぼしてしまう。

【課題を解決するための手段】

本発明の目的は、かかる液晶表示装置において、色ムラの発生を抑制することを目的としている。本発明の別の目的は、そのような、液晶表示装置を容易に作成する製造方法を提供することである。

本発明による液晶表示装置は、透明な第1の基板と透明な第2の基板とこれらに挟まれた液晶層とカラーフィルター層とを有し、そのカラーフィルター層は第1の基板上に配置され、液晶層はカラーフィルター層と第2の基板との間に配置され、カラーフィルター層下の第1の基板上には、複数の走査信号電極と、それらにマトリクス状に交差する複数の映像信号電極と、これらの電極のそれぞれの交点に対応して形成された複数の薄膜トランジスタとを有し、複数の走査信号電極および映像信号電極で囲まれるそれぞれの領域で少なくとも1つの画素が構成され、それぞれの画素には共通電極配線により複数の画素に渡って接続されて基準電位を与える共通電極と、対応する薄膜トランジスタに接続されて画素領域において共通電極に対向して配置された画素電極とを有し、共通電極および画素電極は透明な絶縁物からなる層間分離膜を介して互いに異なった層に配置され、共通電極と画素電極との間に印加される電圧により、液晶層には第1の基板に対して支配的に平行な成分を持った電界が発生するようにし、かつ電圧が印加される前の液晶が第1の基板に対してほぼ平行に配向しているようにした。

また本発明による第2の液晶表示装置は、透明な第1の基板と透明な第2の基板とこれらに挟まれた液晶層とカラーフィルター層とを有し、そのカラーフィルター層は第1の基板上

に配置され、液晶層はカラーフィルター層と第 2 の基板との間に配置され、カラーフィルター層下の第 1 の基板上には、複数の走査信号電極と、それらにマトリクス状に交差する複数の映像信号電極と、これらの電極のそれぞれの交点に対応して形成された複数の薄膜トランジスタとを有し、複数の走査信号電極および映像信号電極で囲まれるそれぞれの領域で少なくとも 1 つの画素が構成され、それぞれの画素には共通電極配線により複数の画素に渡って接続されて基準電位を与える共通電極と、対応する薄膜トランジスタに接続されて画素領域において共通電極に対向して配置された画素電極とを有し、共通電極および画素電極は透明な絶縁物からなる層間分離膜を介して互いに異なった層に配置され、共通電極と画素電極との間に印加される電圧により、液晶層には第 1 の基板に対して支配的に平行な成分を持った電界が発生するようにし、かつ電圧が印加される前の液晶が第 1 の基板に対してほぼ垂直に配向しているようにした。

したがって、共通電極と画素電極との間に印加される電圧により発生した電界で、液晶層における液晶は自動的に 2 つ以上の領域に分かれ、基板に対して平行な方向に倒れていき、その液晶層に発生する電界は、カラーフィルター層に影響しない。

また、本発明における液晶表示装置では、開口率の低下を抑制するために、共通電極または画素電極の少なくとも一方を透明性導電膜で形成してもよい。さらに、画素電極を透明性導電膜で形成し、共通電極を Cr などの金属で形成し、この共通電極と同じ層で TFT を遮光する遮光層を形成してもよい。

また、本発明における液晶表示装置は、視角特性を改善するために、偏光板と液晶セルの間に少なくとも 1 枚の光学補償板を有している。この補償板は電圧無印加時に液晶がホメオトロピック配向をとっているため、光学的に負の補償板を使用することが、斜め方向から見たときのリタデーションの変化を打ち消す観点から好ましい。このような補償板は 2 軸延伸のような方法で作成した 1 枚のフィルムであってもよいし、1 軸延伸したフィルムを 2 枚以上重ねて、実質的に光学的に負の 1 軸の補償板として用いても同様の効果が得られる。さらに、初期配向は原理的に垂直配向であるが、素子の特性により、ある方向に偏りが出た場合などは、さらにこれを補償するために、光学異方性が正のフィルムを貼り付けてもよい。

また、本発明における液晶表示装置は、静電気などによる表示への悪影響を避けるために、第 2 の基板の液晶層と反対側に透明性の導電膜を設けてもよい。

また本発明における液晶表示装置の製造方法は、共通電極と画素電極の間に電圧を印加す

ることによって、初期配向を制御した後、液晶中に少量混合した重合性のモノマーまたはオリゴマーを高分子化することによって、初期の液晶配向をさらに確実なものにすることができる。初期配向を制御する際には、加熱により液晶層を等方相にした後、共通電極と画素電極の間に電圧を加えるながら、温度を降下させても、室温で共通電極と画素電極の間に電圧を印加するだけでもよい。また、モノマーの反応も等方相に加熱する前に起こさせても、加熱中に起こさせてもよいし、冷却後に起こさせてもよい。室温で共通電極と画素電極の間に電圧を印加し、初期配向を制御する場合も、電圧印加の前に反応を起こさせておいてもよいし、電圧印加後に、反応を起こさせてもよい。

また、本発明における液晶表示装置の製造方法は、基板にあらかじめラビン

グ、または光配向などの方法を使用して、分割形状に従ったプレチルト角の制御を行い、初期配向の制御を極めて確実にし、駆動電圧により、このような配向が乱れることを防止するために、さらに液晶中に少量混合した重合性のモノマーまたはオリゴマーを高分子化するとより優れた効果が得られる。また、光配向の場合は、液晶中に少量混合した重合性のモノマーまたはオリゴマーを高分子化することにより、駆動時においてもより確実に分割を維持することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1 A, 1B】 この発明の第 1 の実施の形態における液晶表示装置の構成を示す断面図および平面図である。

【図 2 A- 2E】 実施の形態 1 の液晶表示装置の製造方法を説明するための説明図である。

【図 3 F, 3G】 図 2 A-2E に続く、実施の形態 1 の液晶表示装置の製造方法を説明するための説明図である。

【図 4 A, 4B】 この発明の第 2 の実施の形態における液晶表示装置の構成を示す断面図および平面図である。

【図 5 A, 5B, 5C】 この発明の第 3 の実施の形態における液晶表示装置の構成を示す平面図および断面図である。

【図 6 A-6E】 実施の形態 3 の液晶表示装置の製造方法を説明するための説明図である。

【図 7 A-7C】 この発明の第 4 の実施の形態における液晶表示装置の構成を示す平面図および断面図である。

【図 8 A-8E】 実施の形態 4 の液晶表示装置の製造方法を説明するための説明図である。

【図 9 A-9B】 この発明の第 5 の実施の形態における液晶表示装置の構成を示す平面図および断面図である。

【図 10A-10C】 この発明の第 5 の実施の形態におけるラビング処理の方法を示す工程図である。

【図 11A-11C】 この発明の第 5 の実施の形態におけるラビング処理の他の方法を示す工程図である。

【図 12A, 12B】 従来よりある IPS 方式の TFT 液晶表示装置の構成を示す構成図で

ある。

【発明の実施の形態】

以下この発明の実施の形態を図を参照して説明する。

5 【実施の形態 1】

始めに、この発明の第 1 の実施の形態における液晶表示装置に関して、図 1 を用いて説明する。なお、図 1 において、図 1 (a) は、図 1 (b) の平面図の A A' 線の断面を示している。

この実施の形態 1 の液晶表示装置では、ガラス基板 101 上には、Cr よりなるゲート電極（走査信号電極）102 が配置され、このゲート電極 102 を覆うように窒化シリコンからなるゲート絶縁膜 104 が形成されている。

また、ゲート電極 102 上には、ゲート絶縁膜 104 を介して非晶質シリコンからなる半導体膜 105 が配置され、薄膜トランジスタ（TFT）の能動層として機能するようにされている。また、半導体膜 105 のパターンの一部に重畳するようにモリブデンよりなるドレイン電極 106、ソース電極 107 が配置され、これら全てを被覆するように窒化シリコンよりなる保護膜 108 が形成されている。なお、ドレイン電極 106、ソース電極 107 それぞれは、図示していないが、n 形不純物が導入された非晶質シリコン膜を介し、半導体膜 105 のパターンの一部に重畳している。なお、図 1 (b) に示すように、ドレイン電極 106 は、データ線（映像信号電極）106a に接続している。言い換えると、ドレイン電極 106 は、データ線 106a の一部として形成されている。

そして、この実施の形態 1 では、その保護膜 108 上に、カラーフィルター層 110 が遮光部 111 で区切られて配置されているようにした。また、カラーフィルター層 110 および遮光部 111 上は、オーバーコート層（層間分離膜）112 で覆われている。この、オーバーコート層 112 は、チャージアップしにくい透明な絶縁材料から構成する。

25 そして、保護膜 108、遮光部 111、および、オーバーコート層 112 を貫通して形成されたスルーホールを介してソース電極 107 に接続する画素電極 114 が、オーバーコート層 112 上に配置されている。また、平面的には、1 画素の領域においてその画素電極 114 に対向するように、共通電極配線 103a より引き出されている共通電極 103 が形成されている。ここで、この共通電極 103 は、遮光部 111 上にオーバーコート層 112 で

覆われて配置されている。

従って、この実施の形態 1 においては、共通電極 103 は、カラーフィルター層 110 上に配置され、そして、その共通電極 103 とカラーフィルター層 110 とを覆うように形成されているオーバーコート層 112 上に、画素電極 114 が配置された構成となっている。

5 そして、その画素電極 114 と共通電極 103 とに挟まれた領域で、1 画素が構成された構成となっている。

また、以上のように構成した単位画素をマトリクス状に配置したアクティブマトリクス基板の表面、すなわち、画素電極 114 が形成されたオーバーコート層 112 上には、配向膜 115 が形成されている。この配向膜 115 表面はラビング処理されている。

10 一方、ガラスよりなる対向基板 131 にも配向膜 132 が形成され、この配向膜 132 表面もラビング処理されている。

そして、ガラス基板 101 と対向基板 131 が、配向膜 115 および配向膜 132 形成面で対向配置され、これらの間に液晶組成物層 140 が配置されている用に構成されている。

また、ガラス基板 101 および対向基板 131 の外側の面には、偏光板 151 が形成されている。なお、カラーフィルター層 110 を区切っている遮光部 111 は、その一部の領域が
15 半導体膜 105 よりなる薄膜トランジスタ上に配置するように形成されている。

以上のように構成された TFT 液晶表示装置では、液晶組成物層 140 に電界がかかっていないときは、液晶組成物層 140 における液晶分子はそれら電極の延在方向にほぼ平行な状態となりホモジニアス配向している。すなわち、液晶分子の長軸（光学軸）の方向と、画
20 素電極 114 と共通電極 103 との間に形成される電界方向とのなす角度が、例えば、45° 以上 90° 未満となるように、液晶分子は配向されている。

なお、対向配置されているガラス基板 101 と対向基板 131 と、液晶分子との配向は、互いに平行となっている。また、液晶分子の誘電異方性は正とした。ここで、ゲート電極 102 に電圧を印加して薄膜トランジスタ（TFT）をオンにすると、ソース電極 107 に電
25 圧が印加されて、画素電極 114 とこれに対向配置している共通電極 103 の間に電界が誘起される。そして、この電界により、液晶分子 141 は、画素電極 114 とこれに対向配置している共通電極 103 の間に形成される電界の方向に、ほぼ平行な状態となる。

そして、偏光板 151 の変更透過軸を所定角度に配置しておくことで、上述した液晶分子の動きによって光の透過率を変化させることができる。

次に、上述したこの実施の形態 1 における液晶表示装置の製造方法について簡単に説明する。

まず、Cr 膜を成膜してこれを公知のフォトリソグラフィおよびエッチング技術によりパターニングすることで、図 2 (a) に示すように、ガラス基板 101 上にゲート電極 102 を形成する。

次に、図 2 (b) に示すように、ゲート電極 102 上を含むガラス基板 101 上に窒化シリコンからなるゲート絶縁膜 104 を形成し、これを介してゲート電極 102 上にアモルファスシリコンからなる半導体膜 105 を形成する。この半導体膜 105 は、ゲート絶縁膜 104 上にアモルファスシリコンを堆積した後、公知のフォトリソグラフィおよびエッチング技術により、そのアモルファスシリコンの膜をパターニングすることで形成すればよい。

次に、図 2 (c) に示すように、半導体膜 105 のパターンの一部に重畳するようにモリブデンよりなるドレイン電極 106、ソース電極 107 を形成する。

次に、図 2 (d) に示すように、ドレイン電極 106、ソース電極 107、および、半導体膜 105 を覆うように、ゲート絶縁膜 104 上に保護膜 108 を形成する。

次に、図 2 (e) に示すように、この保護膜 108 上にカラーフィルター層 110 および遮光部 111 を形成する。また、同時に、共通電極 103 を形成する。なお、カラーフィルター層 110 は、例えば、赤色や緑色もしくは青色の染料、顔料を含んだ樹脂膜から構成する。また、遮光部 111 は、黒色の染料、顔料を含んだ樹脂膜から構成すればよい。また、金属を用いて遮光部を形成するようにしても良い。

そのカラーフィルター層 110 は、例えば、赤色などの所望の光学特性が得られる顔料が、アクリルをベースとしたネガ形の感光性樹脂中に分散された、顔料分散レジストを用いて形成すればよい。まず、その顔料分散レジストを保護膜 108 上に塗布することで、そのレジスト膜を形成する。次いで、そのレジスト膜の所定量域、すなわちマトリクス状に配置された画素領域に選択的に光が当たるように、フォトマスクを用いて露光する。この露光の後、所定の現像液を用いて現像し、所定のパターンを形成する。

これらの工程を、色数、例えば赤・青・緑の 3 色分 3 回繰り返すことで、カラーフィルター層 110 が形成できる。

次に、図 3 (f) に示すように、共通電極 103 を含めてカラーフィルター層 110 および遮光部 111 上に透明な絶縁材料からなるオーバーコート層 112 を形成する。このオー

パーコート層 112 は、例えばアクリル樹脂などの熱硬化性樹脂を用いればよい。また、そのオーバーコート層 112 に、光硬化性の透明な樹脂を用いるようにしても良い。

次に、図 3 (g) に示すように、スルーホールを形成してこれを介してソース電極 107 に接続する画素電極 114 を、オーバーコート層 112 上に形成する。

- 5 この後、配向膜 115 を形成した後、液晶組成物層 140 を形成するなどにより、図 1 に示したような、液晶表示装置が完成する。

以上示したように、この実施の形態 1 では、カラーフィルター層 110 上に配置された画素電極 114 とこれに対向配置している共通電極 103 の間に電界を形成することで、それらの上に配置された液晶分子 141 を駆動するようにした。

- 10 従って、この実施の形態によれば、カラーフィルター層 110 と液晶組成物層 140 とが、画素電極 114 と共通電極 103 とを挟んで配置されているようにした。従って、画素電極 114 と共通電極 103 とにより液晶分子 141 を動かすための電界は、カラーフィルター層 110 に何ら影響を与えない。

- 15 また、共通電極 103 上において、オーバーコート層 112 上に液晶組成物層 140 が形成されているが、オーバーコート層 112 は殆どチャージアップしない。

- 20 以上のことにより、この実施の形態 1 によれば、液晶組成物層 140 は、上下に不要な電界がいつでもかかっている状態が抑制されるので、従来とは異なり、表示特性の劣化を起こしにくい構造となっている。また、画素電極 114 と共通電極 103 および共通電極配線 103a とが、オーバーコート層 112 を介して形成されているので、画素電極 114 と共通電極配線 103a とが、接触してしまうことが起こらない。

[実施の形態 2]

始めに、この発明の第 2 の実施の形態における液晶表示装置に関して、図 4 を用いて説明する。なお、図 4 において、図 4 (a) は、図 4 (b) の平面図の BB' 線の断面を示している。

- 25 この実施の形態 2 の液晶表示装置では、ガラス基板 401 上には、Cr よりなるゲート電極 402 が配置され、このゲート電極 402 を覆うように窒化シリコンからなるゲート絶縁膜 404 が形成されている。また、ゲート電極 402 上には、ゲート絶縁膜 404 を介して非晶質シリコンからなる半導体膜 405 が配置され、薄膜トランジスタの能動層として機能するようにされている。

また、半導体膜 405 のパターンの一部に重畳するようにモリブデンよりなるドレイン電極 406、ソース電極 407 が配置され、これら全てを被覆するように窒化シリコンよりなる保護膜 408 が形成されている。なお、ドレイン電極 406、ソース電極 407 それぞれは、図示していないが、n 形不純物が導入された非晶質シリコン膜を介し、半導体膜 405 のパターンの一部に重畳している。なお、図 4 (b) に示すように、ドレイン電極 406 は、データ線 406 a に接続している。以上のことは、前述した実施の形態 1 と同様である。

そして、この実施の形態 2 では、その保護膜 408 上に、カラーフィルター層 410 が配置されているようにした。また、カラーフィルター層 410 は、オーバーコート層 412 で覆われている。この、オーバーコート層 412 は、例えばアクリル樹脂など、チャージアップしにくい透明な材料から構成する。

そして、ソース電極 407 より引き出された引き出し電極 407 a に接続し、画素電極 414 がオーバーコート層 412 上に配置されている。この画素電極 414 は、保護膜 408、~~遮光部 411~~ および、オーバーコート層 412 を貫通するスルーホールを介し、引き出し電極 407 a に接続している。また、この画素電極 414 は ITO ($\text{In}_2\text{O}_3:\text{Sn}$) などの透明電極から構成され、平面的には 1 画素の領域をほぼ半分に分けるように中央部に配置されている。

また、その 1 画素の領域を囲うように、共通電極配線 403 が形成されている。また、この共通電極配線 403 は、カラーフィルター層 410 上にオーバーコート層 412 で覆われて配置されている。そして、この共通電極配線 403 は、上部から見たとき、下層に配置しているドレイン電極 406、データ線 406 a、ソース電極 407、ゲート電極 402 およびそれらで構成される TFT を隠すように配置され、遮光層をかねている。

なお、以上のように構成した単位画素をマトリクス状に配置したアクティブマトリクス基板の表面、すなわち、画素電極 414 が形成されたオーバーコート層 412 上には、配向膜 415 が形成されている。この配向膜 415 表面はラビング処理されている。

一方、ガラスよりなる対向基板 431 にも配向膜 432 が形成され、この配向膜 432 表面もラビング処理されている。そして、ガラス基板 401 と対向基板 431 が、配向膜 415 および配向膜 432 形成面に対向配置され、これらの間に液晶組成物層 440 が配置されている用に構成されている。また、ガラス基板 401 および対向基板 431 の外側の面には、偏光板 451 が形成されている。

このように、この実施の形態2においても、上述した実施の形態1と同様に、共通電極配線403は、カラーフィルター層410上に配置され、そして、その共通電極配線403とカラーフィルター層410とを覆うように形成されているオーバーコート層412上に、画素電極414が配置された構成となっている。

5 この場合、共通電極配線403が、上述した実施の形態1における共通電極もかねている。

そして、この実施の形態2では、格子状に形成された共通電極配線403に囲われた領域で1画素が構成され、その中央部を通り1画素を半分に分けるように画素電極414が配置されているようにした。

10 以上のように構成されたTF-T液晶表示装置では、液晶組成物層440に電界が印加されていないときは、液晶組成物層440における液晶分子はそれら電極の延在方向にほぼ平行な状態となっている。すなわち、液晶分子の長軸（光学軸）の方向と、画素電極414と共通電極配線403との間に形成される電界方向とのなす角度が、例えば、 45° 以上 90° 未満となるように、液晶分子は配向されている。なお、対向配置されているガラス基板401と対向基板431と、液晶分子との配向は、互いに平行となっている。また、液晶分子の誘電異方性は正とした。

ここで、ゲート電極402に電圧を印加して薄膜トランジスタ（TF-T）をオンにすると、ソース電極407に電圧が印加されて、画素電極414とこれに対向配置している共通電極配線403の間に電界が誘起される。そして、この電界により、液晶分子441は、画素電極414とこれに対向配置している共通電極配線403の間に形成される電界の方向に、
20 ほぼ平行な状態となる。

そして、偏光板451の変更透過軸を所定角度に配置しておくことで、上述した液晶分子の動きによって光の透過率を変化させることができる。

以上示したように、この実施の形態2でも、カラーフィルター層410上に配置された画素電極414とこれに対向配置している共通電極配線403の間に電界を形成することで、
25 それらの上に配置された液晶分子441を駆動するようにした。

すなわち、この実施の形態2においても、カラーフィルター層410と液晶組成物層440とが、画素電極414と共通電極配線403とを挟んで配置されているようにした。従って、画素電極414と共通電極配線403とにより液晶分子441を動かすための電界は、カラーフィルター層410に何ら影響を与えない。

また、共通電極配線 4 0 3 上において、オーバーコート層 4 1 2 上に液晶組成物層 4 4 0 が形成されているが、オーバーコート層 4 1 2 は殆どチャージアップしない。

5 以上のことにより、この実施の形態 2 によれば、液晶組成物層 4 4 0 は、上下に不要な電界がいつでもかかっている状態が抑制されるので、従来とは異なり、表示特性の劣化を起しにくい構造となっている。

また、画素電極 4 1 4 と共通電極配線 4 0 3 が、オーバーコート層 4 1 2 を介して形成されているので、画素電極 4 1 4 と共通電極配線 4 0 3 とが、接触してしまうことが起こらない。そして、この実施の形態 2 によれば、前述したように、共通電極配線 4 0 3 が遮光層も兼ねているので、カラーフィルター層の製造工程を簡略化することができる。

10 なお、上記実施の形態 1、2 においては、1つの画素において、共通電極と画素電極とを 1 組だけ設けるようにしたが、これに限るものはない。共通電極と粗電極とを、1つの画素領域において複数組設けるようにしても良い。例えば、櫛形にそれら電極を形成し、対向して配置するようにしても良い。このようにすることで、1つの画素が大きい場合でも、画素電極と共通電極との間の距離を短くできるので、液晶を駆動させるために印加する電圧を
15 小さくできる。

[実施の形態 3]

次に、この発明の第 3 の実施の形態における液晶表示装置に関して、図 5 を用いて説明する。なお、図 5 において (a) は液晶表示装置の一部の画素の平面図であり、(b)、(c) はそれぞれ A-A'、B-B' 線の断面を表している。

20 この第 3 の実施形態の液晶表示装置では、ガラス基板 5 0 1 上にゲート電極 5 0 5 が形成され、ゲート絶縁膜 5 0 4 を介してドレイン電極 5 0 6、ソース電極 5 0 7 からなる薄膜トランジスタが形成され、その上にパッシベーション膜 5 1 2 が形成されている点は実施の形態 1 と同様である。そして、その上にカラーフィルター層 5 1 7 が形成され、それを覆うように第 1 のオーバーコート層 5 1 3 で覆われている。このオーバーコート層 5 1 3 はチャージアップしにくい透明な絶縁材料により構成する。
25

そして、パッシベーション膜 5 1 2 および第 1 のオーバーコート層 5 1 3 を貫通して形成されたスルーホールを介して、ソース電極 5 0 7 に接続する画素電極 5 0 8 が、第 1 のオーバーコート層 5 1 3 上に配置されている。

さらにこれらをすべて覆うように第 2 のオーバーコート層 5 1 4 が形成され、その上に共

通電極配線により引き出されている共通電極 509 が形成されている。ここで第 2 のオーバーコート層 513 は共通電極 509 と画素電極 508 の間の電界が液晶層 515 にかかるようにするため、 $0.1 \sim 1 \mu\text{m}$ 程度に薄膜化し、さらに誘電率の高い材料を用いることが望ましい。

- 5 従って、この実施の形態 3 においては、カラーフィルター 517 上の第 1 のオーバーコート 513 上に画素電極 508 が配置され、これらを覆うように形成されている第 2 のオーバーコート層上に共通電極 509 が配置された構成となっている。そして、その画素電極 508 と共通電極 509 とに挟まれた領域で、1 画素が構成された構成となっている。また共通電極 509 が配線上および TFT 上に配置されており、第 2 の実施形態と同様に遮光を兼ね
- 10 ている。

また以上のように構成した単位画素をマトリクス上に配置したアクティブマトリクス基板の表面および対向基板の表面に配向膜を形成し、所定の方法にラビング処理を行い、アクティブマトリクス基板上に配置された画素電極と共通電極間に発生する横方向電界を用いて液晶を駆動することにより光の透過率を変化させることは第 1 の実施形態と同様である。

- 15 なお、液晶層 515 は、対向基板 516 と第 2 のオーバーコート層 514 の間に挟まれている。

次に、上述したこの第 3 の実施形態における液晶表示装置の製造方法について簡単に説明する。

- 図 6 (a) に示すように、ガラス基板 501 上に薄膜トランジスタを形成し、それらを保護するパッシベーション膜 512 を堆積した後、顔料分散型の感光性アクリル樹脂などを用いてカラーフィルターを形成することは実施形態 1 と同様である。
- 20

次に図 6 (b) のように、透明の感光性アクリル樹脂などを用いて第 1 のオーバーコート層を形成し、スルーホール 518 を開口し、同時にパッシベーション膜 512 上のスルーホールも開口する。

- 25 次に、図 6 (c) に示すように、スルーホール 518 を介してソース電極 508 に接続する画素電極 508 を、ITO などにより第 1 のオーバーコート層上に形成する。

次に図 6 (d) に示すように、第 2 のオーバーコート膜を形成する。第 2 のオーバーコート膜を感光性の有機膜などを塗布法により形成する場合、スルーホール 508 が平坦化され、画素電極と共通電極間のショートなどもなくなり、好ましい。

そして、図6 (e) に示すようにクロム・モリブデンなどにより共通電極509を形成している。

以上のことによりこの実施形態3によれば、液晶層515は上下に不要な電界がいつでもかかっている状態が抑制されるので、従来とは異なり、表示の劣化を起こしにくい構造になっている。また、第1のオーバーコート層上のスルーホールは第2のオーバーコートにより平坦化されるため、画素電極と共通電極間のショートが少なくなる構造となっている。

〔実施の形態4〕

次に、この発明の第4の実施の形態における液晶表示装置に関して、図7を用いて説明する。なお、図7において(a)は液晶表示装置の一部の画素の平面図であり、(b)、(c)はそれぞれA-A'、B-B'線の断面を表している。

この実施の形態4の液晶表示装置では、TFTガラス基板上にゲート電極705が形成され、ゲート絶縁膜704を介して、ドレイン電極706、ソース電極707からなる薄膜トランジスタが形成され、その上にパッシベーション膜712が形成されている点は第1の実施形態と同様である。

また、その上にカラーフィルター層717が形成され、それを覆うように第1のオーバーコート層713が覆われている。このオーバーコート層713はチャージアップしにくい透明な絶縁材料により構成する。そして、パッシベーション膜712および第1のオーバーコート層713上に共通電極配線により引き出されている共通電極709が形成されている。さらにこれらを全て覆うように第2のオーバーコート層714が形成され、第2のオーバーコート層を貫通して形成されたスルーホールを介して、ソース電極707に接続する画素電極708が配置されている。

ここで第2のオーバーコート層は共通電極と画素電極の間の電界が液晶層715にかかるようにするため、0.1~1 μ m程度に薄膜化し、さらに誘電率の高い材料を用いることが好ましい。

従って、この第4の実施形態においては、カラーフィルター717上の第1のオーバーコート713上に共通電極709が配置され、これらを覆うように形成されている第2のオーバーコート層上に画素電極708が配置された構成となっている。

そして、その画素電極708と共通電極709とに挟まれた領域で、1画素が構成された

構成となっている。また共通電極 709 が配線上および T F T 上に配置されており、第 2 の実施形態と同様に遮光を兼ねている。

また、以上のように構成した単位画素をマトリクス上に配置したアクティブマトリクス基板の表面および対向基板の表面に配向膜を形成し、所定の方高にラビング処理を行い、アクティブマトリクス基板上に配置された画素電極と共通電極間に発生する横方向電界を用いて液晶を駆動することにより光の透過率を変化させることは第 1 の実施形態と同様である。

なお、液晶層 715 は、対向基板 716 と第 2 のオーバーコート層 714 の間に挟まれている。

次に、上述したこの第 4 の実施形態における液晶表示装置の製造方法について簡単に説明する。図 8 (a) に示すように、ガラス基板 710 上に薄膜トランジスタを形成し、それらを保護するパッシベーション膜 712 を堆積した後、顔料分散型の感光性アクリル樹脂などを用いてカラーフィルターを形成することは第 1 の実施形態と同様である。

次に図 8 (b) のように、第 1 のオーバーコート層を塗布した後、共通電極 709 をクロム・モリブデンなどの金属によりパターン形成する。

次に図 8 (c) に示すように、第 2 のオーバーコート膜を塗布した後、第 1、2 のオーバーコート膜およびパッシベーション膜を貫通するスルーホール 718 を形成する。

最後に、図 8 (d) に示すように、スルーホール 718 を介してソース電極 707 に接続する画素電極 708 を、ITO などにより第 2 のオーバーコート層上に形成する。

以上のことにより、この実施形態 4 によれば、液晶層 715 は、上下に不要な電界がいつでもかかっている状態が抑制されるので、従来とは異なり、表示特性の劣化をおこしにくい構造となっている。また、第 1、2 のオーバーコート層のパターニングを一括して行ってスルーホールを形成するので、第 3 の実施形態に比べて製造工程が短縮される。

【実施の形態 5】

次に、本発明の第 5 の実施の形態における液晶表示装置を、図 9 を用いて説明する。なお、図 9 において、図 9 (a) は、図 9 (b) の平面図の A A' 線の断面を示している。

実施の形態 1 と同様に構成した単位画素をマトリクス状に配置したアクティブマトリクス基板の表面、すなわち、画素電極 914 が形成されたオーバーコート層 912 上には、垂直配向膜 915 が形成されている。この配向膜 915 表面は、必要に応じラビング、または、光配向処理が施される。

一方、透明性基板よりなる対向基板 9 3 1 にも垂直配向膜 9 3 2 が形成され、この配向膜 9 3 2 の表面も必要に応じ、ラビング、または、光配向処理が施される。また、静電気による画質の低下を防ぐ目的で、対向基板の配向膜と反対側の表面に、ITOなどの透明性導電膜を設けてもよい。

5 基板 9 0 1 と対向基板 9 3 1 は配向膜 9 1 5 および配向膜 9 3 2 形成面で対向配置され、これらの間に液晶層 9 4 0 が配置される。また、透過型で使用する場合は基板 9 0 1 および対向基板 9 3 1 の外側の面には、偏光板 9 5 1 が形成されている。なお、カラーフィルター層 9 1 0 を区切っている遮光部 9 1 1 は、その一部の領域が半導体膜 9 0 5 よりなる薄膜トランジスタ上に配置するように形成されている。

10 以上のように構成されたアクティブマトリクス型液晶表示装置では、液晶層 9 4 0 に電界がかかっていないときには、液晶層 9 4 0 における液晶分子は、基板にほぼ垂直に配向している。液晶の誘電率異方性は正とする。

ここで、ゲート電極 9 0 2 に電圧を印加して薄膜トランジスタ (TFT) をオンにすると、ソース電極 9 0 7 に電圧が印加され、画素電極 9 1 4 とこれに対向配置している共通電極 9 0 3 の間に電界が誘起される。そして、この電界により、液晶分子 9 4 1 は画素電極 9 1 4 とこれに対向配置している共通電極 9 0 3 の間に形成される電界の方向に、ほぼ平行な状態、すなわち、基板方向に倒れていくことになる。

また、このとき電界の方向が完全に基板と平行でないため、電極間の液晶分子は 2 方向に分かれて倒れる。

20 このように本発明の方法では、特別に配向膜に処理を加えることをしなくても、自動的に液晶の倒れる方向を分割することができ、広視野角化が達成できる。

しかし、液晶の方向の異なる方向に倒れるそれぞれの領域は、電界の方向のみで制御され、明確に分かれていない。このため、液晶の配向状態が悪い場合は、その境界が表示画面によって画素内を移動する場合があります、表示不良を発生させる原因となる。

25 そこで、その液晶の倒れる方向が変わる境界をより完全に制御するために、その境界を次に示すようにして固定するようにしても良い。

その 1 つの方法としては、図 1 0 に示すように、領域毎に異なるラビング処理を行うようにすればよい。

まず、図 1 0 (a) に示すように、画素内の境界を境に一方の領域の垂直配向膜 9 1 5 上

に、レジストパタン 1 0 0 1 を形成し、この状態でラビングロール 1 0 1 0 を所定の方向に移動させる。このことにより、垂直配向膜 9 1 5 のレジストパタン 1 0 0 1 に覆われていない領域が、所定の方向にラビング処理されたことになる。しかしここでは、レジストパタン 1 0 0 1 で覆われた領域は、ラビング処理されない。

- 5 次に、レジストパタン 1 0 0 1 を除去した後、図 1 0 (b) に示すように、画素内の境界を境に他方の領域の垂直配向膜 9 1 5 上に、レジストパタン 1 0 0 2 を形成する。すなわち、すでにラビング処理された領域を覆うように、レジストパタン 1 0 0 2 を形成する。そして、この状態で、ラビングロール 1 0 1 0 を上述とは反対の方向に移動させる。

- 10 とのことにより、垂直配向膜 9 1 5 のレジストパタン 1 0 0 2 に覆われていない領域が、すでにラビング処理された領域とは異なる方向にラビング処理されたことになる。そして、この処理では、すでにラビング処理された領域は、レジストパタン 1 0 0 2 で覆われているので、再度ラビング処理されることがない。

- 15 そして、レジストパタン 1 0 0 2 を除去した後、対向基板 9 3 1 側の垂直配向膜 9 3 2 も同様に処理し、図 1 0 (c) に示すように、それらの間に液晶層 9 4 0 を配置すればよい。これらの結果、液晶層 9 4 0 では、境界を境に、液晶分子 9 4 1 が異なる方向に倒れるようになる。すなわち、上述したことにより、分割領域を固定することができる。

- 20 また、その液晶の倒れる方向が変わる境界をより完全に制御するために、その境界を次に示すようにして固定するようにしても良い。この 2 つ目の方法は、偏光した光を照射することで配向方向が定まる光配向膜を用いるようにしたものである。

- 25 以下、より詳細に説明すると、まず、図 1 1 (a) に示すように、光配向膜からなる垂直配向膜 9 1 5 を形成したら、所定の境界を境に一方の領域を遮光するマスク 1 1 0 1 を配置し、この状態で斜め方向から偏光した光 1 1 1 0 を上部より照射する。このことにより、垂直配向膜 9 1 5 のマスク 1 1 0 1 に覆われていない領域が、配向状態を規定されたことになる。しかしここでは、マスク 1 1 0 1 が上部にある領域は、配向状態が規定されていない。

次に、図 1 1 (b) に示すように、画素内の境界を境に他方の領域の垂直配向膜 9 1 5 上に、マスク 1 1 0 2 を配置する。すなわち、すでに配向状態が規定された領域を覆うように、マスク 1 1 0 2 を配置する。そして、この状態で、今度は、上述とは反対側の斜め方向から偏光した光を上部より照射する。このことにより、垂直配向膜 9 1 5 のマスク 1 1 0 2 に覆

われていない領域が、所定の配向状態を規定されたことになる。

このことにより、垂直配向膜 9 1 5 のマスク 1 1 0 2 に覆われていない領域が、すでに配向状態が規定された領域とは異なる方向に、配向状態が規定されたことになる。そして、この処理では、すでに配向状態が規定された領域は、マスク 1 1 0 2 が上部にあって光が照射
5 されないで、再度配向状態が規定されることがない。

そして、図 1 1 (c) に示すように、対向基板 9 3 1 側の垂直配向膜 9 3 2 も同様に処理し、それらの間に液晶層 9 4 0 を配置すればよい。これらの結果、液晶層 9 4 0 では、境界を境に、液晶分子 9 4 1 が異なる方向に倒れるようになる。すなわち、上述したことにより、分割領域を固定することができる。

10 なお、その光配向膜としては、ケイ皮酸基のような偏光により液晶の配向を制御できる官能基を有する物質、または、エーエムエルシーディー' 9 6 / アイディーダブリュー' 9 6 のダイジェストオブテクニカルペーパーズ (AM-LCD' 9 6 / IDW' 9 6 Digest of Technical Papers) P.337 に記載されているような偏光照射により感光基が重合するような高分子を用いればよい。

15 さらに、上述した 2 つの方法でも液晶の配向の乱れを抑制できない場合には、有機高分子材料を用いて液晶の配向状態を記憶させておくようにしても良い。これは、はじめに、その材料のモノマーやオリゴマーを液晶に導入しておき、次いで、液晶を所定の配向方向状態にしておき、その状態で、紫外線を照射することなどによりモノマーを重合させポリマーとさせればよい。この結果、液晶の配向状態が記憶された状態となる。

20 なお、上述した有機高分子材料とするモノマー、オリゴマとしては、光硬化性モノマー、熱硬化性モノマー、あるいはこれらのオリゴマ等のいずれを使用することもでき、また、これらを含むものであれば他の成分を含んでいてもよい。本発明に使用する「光硬化性モノマー又はオリゴマ」とは、可視光線により反応するものだけでなく、紫外線により反応する紫外線硬化モノマー等を含み、操作の容易性からは特に後者が望ましい。

25 また、それら高分子化合物は、液晶性を示すモノマー、オリゴマーを含む液晶分子と類似の構造を有するものでもよいが、必ずしも液晶を配向させる目的で使用されるものではないため、アルキレン鎖を有するような柔軟性のあるものであってもよい。また、単官能性のものでもよいし、2 官能性のもの、3 官能以上の多官能性を有するモノマー等でもよい。本発明で使用する光または紫外線硬化モノマーとしては、例えば、次にあげるものを用いれ

ばよい。

まず、2-エチルヘキシルアクリレート、ブチルエチルアクリレート、ブトキシエチルア
クリレート、2-シアノエチルアクリレート、ベンジルアクリレート、シクロヘキシルアク
リレート、2-ヒドロキシプロピルアクリレート、2-エトキシエチルアクリレート、N、
5 N-エチルアミノエチルアクリレート、N、N-ジメチルアミノエチルアクリレート、ジシ
クロペンタニルアクリレート、ジシクロペンテニルアクリレート、グリシジルアクリレート、
テトラヒドロフルフリルアクリレート、イソボニルアクリレート、イソデシルアクリレート、
ラウリルアクリレート、モルホリンアクリレート、フェノキシエチルアクリレート、フェノ
キシジエチレングリコールアクリレート、2，2，2-トリフルオロエチルアクリレート、
10 2，2，3，3，3-ペンタフルオロプロピルアクリレート、2，2，3，3-テトラフルオ
ロプロピルアクリレート、2，2，3，4，4，4-ヘキサフルオロブチルアクリレート等
の単官能アクリレート化合物を使用することができる。

また、2-エチルヘキシルメタクリレート、ブチルエチルメタクリレート、ブトキシエチ
ルメタクリレート、2-シアノエチルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、シクロヘ
15 キシルメタクリレート、2-ヒドロキシプロピルメタクリレート、2-エトキシエチルアク
リレート、N、N-ジエチルアミノエチルメタクリレート、N、N-ジメチルアミノエチル
メタクリレート、ジシクロペンタニルメタクリレート、ジシクロペンテニルメタクリレート、
グリシジルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、イソボニルメタクリ
レート、イソデシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、モルホリンメタクリレート、
20 フェノキシエチルメタクリレート、フェノキシジエチレングリコールメタクリレート、2，
2，2-トリフルオロエチルメタクリレート、2，2，3，3-テトラフルオロプロピルメ
タクリレート、2，2，3，4，4，4-ヘキサフルオロブチルメタクリレート等の単官能
メタクリレート化合物を使用することができる。

さらに、4，4'-ビフェニルジアクリレート、ジエチルスチルベストロールジアクリレ
25 ート、1，4-ビスアクリロイルオキシベンゼン、4，4'-ビスアクリロイルオキシジフ
ェニルエーテル、4，4'-ビスアクリロイルオキシジフェニルメタン、3，9-ビス〔1，
1-ジメチル-2-アクリロイルオキシエチル〕-2，4，8，10-テトラスピロ〔5，
5〕ウンデカン、 α ， α' -ビス〔4-アクリロイルオキシフェニル〕-1，4-ジイソブ
ロピルベンゼン、1，4-ビスアクリロイルオキシテトラフルオロベンゼン、4，4'-ビ

スアクリロイルオキシオクタフルオロビフェニル、ジエチレングリコールジアクリレート、
1, 4-ブタンジオールジアクリレート、1, 3-ブチレングリコールジアクリレート、ジ
シクロペンタニルジアクリレート、グリセロールジアクリレート、1, 6-ヘキサジオール
5 ジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、テトラエチレングリコールジ
アクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラア
クリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラア
クリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ジペンタエリスリトールモノヒ
ドロキシペンタアクリレート、4, 4'-ジアクリロイルオキシスチルベン、4, 4'-ジア
10 クリロイルオキシジメチルスチルベン、4, 4'-ジアクリロイルオキシジエチルスチルベ
ン、4, 4'-ジアクリロイルオキシジプロピルスチルベン、4, 4'-ジアクリロイルオキ
シジブチルスチルベン、4, 4'-ジアクリロイルオキシジペンチルスチルベン、4, 4'-
ジアクリロイルオキシジヘキシルスチルベン、4, 4'-ジアクリロイルオキシジフルオロ
スチルベン、2, 2, 3, 3, 4, 4-ヘキサフルオロペンタンジオール-1, 5-ジアク
リレート、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフルオロプロピル-1, 3-ジアクリレート、
15 ウレタンアクリレートオリゴマ等の多官能アクリレート化合物を用いることができる。

さらにまた、ジエチレングリコールジメタクリレート、1, 4-ブタンジオールジメタク
リレート、1, 3-ブチレングリコールジメタクリレート、ジシクロペンタニルジメタク
リレート、グリセロールジメタクリレート、1, 6-ヘキサジオールジメタクリレート、ネ
オペンチルグリコールジメタクリレート、テトラエチレングリコールジメタクリレート、ト
20 リメチロールプロパントリメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、
ペンタエリスリトールトリメタクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラメタクリレ
ート、ジペンタエリスリトールヘキサメタクリレート、ジペンタエリスリトールモノヒドロキ
シペンタメタクリレート、2, 2, 3, 3, 4, 4-ヘキサフルオロペンタンジオール-1, 5-
ジメタクリレート、ウレタンメタクリレートオリゴマ等の多官能メタクリレート化合物、
25 その他スチレン、アミノスチレン、酢酸ビニル等があるが、これに限定されるものではない。

また、本発明では、液晶表示装置の各素子の駆動電圧は、高分子材料と液晶材料の界面相
相互作用にも影響されるため、フッ素元素を含む高分子化合物であってもよい。このような高
分子化合物として、2, 2, 3, 3, 4, 4-ヘキサフルオロペンタンジオール-1, 5-
ジアクリレート、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフルオロプロピル-1, 3-ジアクリレ

ート、2, 2, 2-トリフルオロエチルアクリレート、2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオ
ロプロピルアクリレート、2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピルアクリレート、2, 2,
3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロブチルアクリレート、2, 2, 2-トリフルオロエチルメ
タクリレート、2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピルメタクリレート、2, 2, 3, 4,
5 4, 4-ヘキサフルオロブチルメタクリレート、ウレタンアクリレートオリゴマを含む化
合物から合成された高分子化合物が挙げられるが、これに限定されるものではない。本発明
に使用する高分子化合物として光または紫外線硬化モノマーを使用する場合には、光または
紫外線用の開始剤を使用することもできる。

この開始剤としては、種々のものが使用可能であり、たとえば、2, 2-ジエトキシアセ
10 トフェノン、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニル-1-オン、1-(4-イソプロ
ピルフェニル)-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-1-オン、1-(4-ドデシルフ
ェニル)-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-1-オン等のアセトフェノン系、ベンゾ
インメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンジルジメチルケタール等のベンゾイ
ン系、ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸、4-フェニルベンゾフェノン、3, 3-ジメ
15 チル-4-メトキシベンゾフェノン等のベンゾフェノン系、チオキサンソン、2-クロルチ
オキサンソン、2-メチルチオキサンソン等のチオキサンソン系、ジアゾニウム塩系、スル
ホニウム塩系、ヨードニウム塩系、セレンニウム塩系等が使用できる。

そして、偏光板 9 5 1 の偏光透過軸を所定角度に配置しておくことで、上述した液晶分子
の動きによって光の透過率を変化させることができる。

20 また、偏光透過軸を直交させた場合は、ノーマリブラックモードとなるが、初期の液晶配
向のリタデーションの観察角度依存をなくすため負の一軸の補償フィルムおよび正の一軸
の補償フィルムを組み合わせる用いることができる。これにより、黒状態の観察角度依存性
がなくなり、画質が向上するとともに、広視野角化が図れる。

25 以上のことにより、この実施の形態 5 によれば、液晶層 9 4 0 は上下に不要な電界がいつ
でもかかっている状態が抑制されるので、従来とは異なり、表示特性の劣化を起こしにくい
構造となっている。また、液晶分子が基板に対しほぼ垂直に配向した状態から、電界により
倒れる構成のため、従来のような液晶分子が単に基板に平行な面内で回転する構成に比べ、
斜め方向から観察したときの色付きもなく、広い視野角特性を与える。

【実施例】

以下、実施例を用いて、本発明をより詳細に説明する。

（実施例 1）

アモルファスシリコン薄膜トランジスタアレイ（TFT）を有する基板を、成膜過程とリソグラフィ過程を繰り返して、ガラス基板上に作製した。このTFTは、基板側よりゲートクロム層、窒化珪素ゲート絶縁層、アモルファスシリコン半導体層、ドレイン・ソースモリブデン層から構成されている（図2（c）参照）。

これらを覆うように窒化珪素からなる保護膜を成膜した。

次に、例えば緑のカラーフィルター層を保護膜上に塗布、加熱乾燥後、フォトリソグラフィにより形成した。赤、青のカラーフィルター層について同様の操作を繰り返しカラーフィルター層を作成し、同様にして、黒い顔料を含んだ樹脂を用いて、遮光部を形成した。

クロムを用いて共通電極を作成した後、アクリル樹脂からなるオーバーコート層を塗布し、200℃で1時間、加熱した。

次にフォトリソグラフィ、エッチングを用いて、ソース電極までスルーホールを形成した。

クロムを用いて画素電極を形成し、垂直配向膜として日産化学社製SE1211を塗布し、200℃で1時間加熱した。

裏面にITOを成膜したガラス基板に、垂直配向膜として日産化学社製SE1211を塗布し、200℃、1時間の加熱を行い対向基板とした。

基板の周辺部にシール材を塗布し、配向膜を塗布した面が向いあうようにスペーサー材を介して重ねあわせ、160℃、3時間加熱することによってシール材を硬化させた。このとき対向基板はまったくのベタ基板であるので、精度の高い目合わせは不要であった。

誘電率異方性が正のネマチック液晶を注入し、注入孔を光硬化樹脂で封止した。液晶層の $\Delta n d$ と大きさが等しく、符号が逆となる光学的に負の補償フィルムを貼り付けた後、偏光板を上下基板にその透過軸が直交するように貼り付けた。

このようにして得られたパネルの視角特性を測定したところ、階調反転は全くなく、高コントラストの領域が非常に広い優れた視角特性が得られた。特に、通常の横方向電界で駆動するパネルでみられるような斜め方向から見たときの色付きがなく、また、色ムラなども全く見られず、優れた視角特性を示した。

(実施例 2)

実施例 1 と同様にして、ガラス基板上に、成膜過程とリソグラフィー過程を繰り返して、アモルファスシリコン薄膜トランジスタアレイ (TFT) を作成した。

この TFT は、実施例 1 と同様に、基板側よりゲートクロム層、窒化珪素ゲート絶縁層、アモルファスシリコン半導体層、ドレイン・ソースモリブデン層から構成されている。

これらを覆うように窒化珪素からなる保護膜を成膜し、実施例 1 と同様にして、赤、青、緑のカラーフィルター層を形成した。クロムを用いて共通電極を作成した後、アクリル樹脂からなるオーバーコート層を塗布し、200℃で1時間、加熱した。

次に、ソース電極までスルーホールを形成し、ITOを用いて画素電極を形成した。

実施例 1 と全く同様にして、垂直配向膜として日産化学社製 SE1211 を塗布し、200℃で1時間加熱した。

裏面に ITO を成膜したガラス基板に、垂直配向膜として日産化学社製 SE1211 を塗布し、200℃、1時間の加熱を行い対向基板とした。

基板の周辺部にシール材を塗布し、配向膜を塗布した面が向いあうようにスペーサー材を介して重ねあわせ、160℃、3時間加熱することによってシール材を硬化させた。このとき対向基板はまったくのベタ基板であるので、精度の高い目合わせは不要であった。

誘電率異方性が正のネマチック液晶を注入し、注入孔を光硬化樹脂で封止した。液晶層の $\Delta n d$ と大きさが等しく、符号が逆となる光学的に負の補償フィルムを貼り付けた後、偏光板を上下基板にその透過軸が直交するように貼り付けた。

このようにして得られたパネルの視角特性を測定したところ、階調反転は全くなく、高コントラストの領域が非常に広い優れた視角特性が得られた。特に、通常の横方向電界で駆動するパネルでみられるような斜め方向から見たときの色付きがなく、また、色ムラなども全く見られず、優れた視角特性を示した。なお、画素電極を ITO で作成したため、開口率が高く、明るい表示が得られた。

[発明の効果]

以上説明したように、この発明では、透明な第1の基板と透明な第2の基板とこれらに挟まれた液晶層とカラーフィルター層とを有する液晶表示装置において、そのカラーフィルター層は第1の基板上に配置され、液晶層はカラーフィルター層と第2の基板との間に配置さ

れ、カラーフィルター層下の第1の基板上には、複数の走査信号電極と、それらにマトリクス状に交差する複数の映像信号電極と、これらの電極のそれぞれの交点に対応して形成された複数の薄膜トランジスタとを有し、複数の走査信号電極および映像信号電極で囲まれるそれぞれの領域で少なくとも1つの画素が構成され、それぞれの画素には共通電極配線により

5 複数の画素に渡って接続されて基準電位を与える共通電極と、対応する薄膜トランジスタに接続されて画素領域において共通電極に対向して配置された画素電極とを有し、共通電極および画素電極は、カラーフィルター層と液晶層との間に配置され、かつ、共通電極と画素電極は透明な絶縁物からなる層間分離膜を介して互いに異なった層に配置され、共通電極と画素電極との間に印加される電圧により、液晶層には第1の基板に対して支配的に平行な成分

10 を持った電界が発生するようにした。

従って、共通電極と画素電極との間に印加される電圧により発生した電界で、液晶層における液晶は基板に対してほぼ平行な面で回転し、その液晶層に発生する電界は、カラーフィルター層に影響しない。この結果、この発明によれば、カラーフィルター層に部分的に発生するチャージアップを抑制できるので、多色表示の液晶表示装置の色ムラの発生を抑制できる

15 ようになる。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 透明な第 1 の基板と透明な第 2 の基板とこれらに挟まれた液晶層とカラーフィルター層とを有する液晶表示装置において、

5

前記カラーフィルター層は前記第 1 の基板上に配置され、

前記液晶層は前記カラーフィルター層と前記第 2 の基板との間に配置され、

10

前記カラーフィルター層下の前記第 1 の基板上には、複数の走査信号電極と、それらにマトリクス状に交差する複数の映像信号電極と、これらの電極のそれぞれの交点に対応して形成された複数の薄膜トランジスタとを有し、

前記複数の走査信号電極および映像信号電極で囲まれるそれぞれの領域で少なくとも 1 つの画素が構成され、

15

それぞれの画素には共通電極配線により複数の画素に渡って接続されて基準電位を与える共通電極と、対応する薄膜トランジスタに接続されて前記画素領域において前記共通電極に対向して配置された画素電極とを有し、

前記共通電極および前記画素電極は、前記カラーフィルター層と前記液晶層との間に配置され、かつ、前記共通電極と前記画素電極は透明な絶縁物からなる層間分離膜を介して互い

20

に異なった層に配置され、

前記共通電極と前記画素電極との間に印加される電圧により、前記液晶層には前記第 1 の基板に対して支配的に平行な成分を持った電界が発生し、かつ電圧が印加する前の液晶が第 1 の基板に対してほぼ平行に配向している

ことを特徴とする液晶表示装置。

25

【請求項 2】 請求項 1 記載の液晶表示装置において、

前記共通電極および前記画素電極のうち少なくとも一方は透明性導電膜よりなることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3】 請求項 1 記載の液晶表示装置において、

前記カラーフィルター層上に共通電極が形成され、
この共通電極上に前記層間分離膜が形成され、
前記層間分離膜上に画素電極が形成され
たことを特徴とする液晶表示装置。

- 5 【請求項 4】 請求項 1 記載の液晶表示装置において、
前記カラーフィルター層上に前記カラーフィルター層を保護するオーバーコート層が形成され、

このオーバーコート層上に共通電極が形成され、
この共通電極上に前記層間分離膜が形成され、

- 10 前記層間分離膜上に画素電極が形成され
たことを特徴とする液晶表示装置。

 【請求項 5】 請求項 1 記載の液晶表示装置において、
前記カラーフィルター層上に前記カラーフィルター層を保護するオーバーコート層が形成され、

- 15 このオーバーコート層上に画素電極が形成され、
この画素電極上に前記層間分離膜が形成され、
前記層間分離膜上に共通電極が形成され
たことを特徴とする液晶表示装置。

- 【請求項 6】 請求項 1 記載の液晶表示装置において、
20 前記共通電極は前記画素を囲うように格子状に形成され、
前記画素電極は前記画素の中を横切るように配置され、
前記共通電極が前記共通電極配線の一部を共用して形成されたことを特徴とする液晶表示装置。

- 【請求項 7】 請求項 1 記載の液晶表示装置において、
25 前記共通電極および画素電極が、前記画素内に複数組配置されたことを特徴とする液晶表示装置。

 【請求項 8】 請求項 6 記載の液晶表示装置において、
前記共通電極は、前記第 2 の基板側から見て、前記薄膜トランジスタが隠れるように形成されたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 9】 請求項 6 記載の液晶表示装置において、

前記共通電極は、前記第 2 の基板側から見て、前記走査信号電極および映像信号電極が隠れるように形成されたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 10】 第 1 の基板と透明な第 2 の基板とこれらに挟まれた液晶層とカラーフ

5 イルター層とを有する液晶表示装置において、

前記カラーフィルター層は前記第 1 の基板上に配置され、

前記液晶層は前記カラーフィルター層と前記第 2 の基板との間に配置され、

前記カラーフィルター層下の前記第 1 の基板上には、複数の走査信号電極と、

それらにマトリクス状に交差する複数の映像信号電極と、これらの電極のそれぞれの交点に

10 対応して形成された複数の薄膜トランジスタとを有し、

前記複数の走査信号電極および映像信号電極で囲まれるそれぞれの領域で少なくとも 1 つの画素が構成され、

それぞれの画素には共通電極配線により複数の画素に渡って接続されて基準電位を与える共通電極と、対応する薄膜トランジスタに接続されて前記画素領域において前記共通電極

15 に対向して配置された画素電極とを有し、

前記共通電極および前記画素電極は、前記カラーフィルター層と前記液晶層との間に配置され、かつ、前記共通電極と前記画素電極は透明な絶縁物からなる層間分離膜を介して互いに異なった層に配置され、

前記共通電極と前記画素電極との間に印加される電圧により、前記液晶層には前記第 1 の
20 基板に対して支配的に平行な成分を持った電界が発生し、かつ電圧が印加される前の液晶が第 1 の基板に対してほぼ垂直に配向していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 11】 請求項 10 記載の液晶表示装置において、

前記共通電極および前記画素電極のうち少なくとも一方は透明性導電膜よりなることを特徴とする液晶表示装置。

25 【請求項 12】 請求項 10 記載の液晶表示装置において、

前記カラーフィルター層上に共通電極が形成され、

この共通電極上に前記層間分離膜が形成され、

前記層間分離膜上に画素電極が形成され

たことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 1 3】 請求項 1 0 記載の液晶表示装置において、
前記カラーフィルター層上に前記カラーフィルター層を保護するオーバーコート層が形成され、

- このオーバーコート層上に共通電極が形成され、
5 この共通電極上に前記層間分離膜が形成され、
前記層間分離膜上に画素電極が形成され
たことを特徴とする液晶表示装置。

- 【請求項 1 4】 請求項 1 0 記載の液晶表示装置において、
前記カラーフィルター層上に前記カラーフィルター層を保護するオーバーコート層が形成され、
10

このオーバーコート層上に画素電極が形成され、
この画素電極上に前記層間分離膜が形成され、
前記層間分離膜上に共通電極が形成され
たことを特徴とする液晶表示装置。

- 15 【請求項 1 5】 請求項 1 0 記載の液晶表示装置において、
前記共通電極は前記画素を囲うように格子状に形成され、
前記画素電極は前記画素の中を横切るように配置され、
前記共通電極が前記共通電極配線の一部を共用して形成されたことを特徴とする液晶表示装置。

- 20 【請求項 1 6】 請求項 1 0 記載の液晶表示装置において、
前記共通電極および画素電極が、前記画素内に複数組配置されたことを特徴とする液晶表示装置。

- 【請求項 1 7】 請求項 1 5 記載の液晶表示装置において、
前記共通電極は、前記第 2 の基板側から見て、前記薄膜トランジスタが隠れるように形成
25 されたことを特徴とする液晶表示装置。

- 【請求項 1 8】 請求項 1 5 記載の液晶表示装置において、
前記共通電極は、前記第 2 の基板側から見て、前記走査信号電極および映像信号電極が隠れるように形成されたことを特徴とする液晶表示装置。

- 【請求項 1 9】 請求項 1 0 に記載の液晶表示装置において、

光学的に負の補償フィルムと光学的に正の補償フィルムを第 1 または第 2 の基板と偏光板との間に設置することにより、液晶層と補償フィルムの屈折率異方性を等方的にしたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 20】 請求項 19 に記載の液晶表示装置において、

- 5 電圧を印加した際に液晶が倒れる 2 方向に沿ってあらかじめプレチルト角が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 21】 請求項 19 に記載の液晶表示装置において、

電圧を印加した際に液晶が倒れるどちらか一方の方向にあらかじめプレチルト角が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

- 10 【請求項 22】 請求項 10 に記載の液晶表示装置において、

液晶が高分子高分子有機化合物を含むことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 23】 第 1 の基板と透明な第 2 の基板とこれらに挟まれた液晶層とカラーフィルター層とを有する液晶表示装置の製造方法において、

前記カラーフィルター層を前記第 1 の基板上に形成し、

- 15 前記液晶層を前記カラーフィルター層と前記第 2 の基板との間に形成し、

前記カラーフィルター層下の前記第 1 の基板上に、複数の走査信号電極と、それらにマトリクス状に交差する複数の映像信号電極と、これらの電極のそれぞれの交点に対応して形成された複数の薄膜トランジスタと形成し、

前記複数の走査信号電極および映像信号電極で囲まれるそれぞれの領域で少なくとも 1

- 20 つの画素を構成し、

それぞれの画素には共通電極配線により複数の画素に渡って接続されて基準電位を与える共通電極と、対応する薄膜トランジスタに接続されて前記画素領域において前記共通電極に対向配置する画素電極とを形成し、

前記共通電極および前記画素電極を、前記カラーフィルター層と前記液晶層との間に配置

- 25 し、かつ、前記共通電極と前記画素電極は透明な絶縁物からなる層間分離膜を介して互いに異なった層に配置し、

前記液晶は、前記共通電極と前記画素電極との間に印加される電圧が印加されていないときは、第 1 の基板に対してほぼ垂直に配向している状態に形成し、

前記液晶にモノマーまたはオリゴマからなる有機材料を添加し、その液晶を前記第 1 の基

板と前記第 2 の基板の間に注入した後に、前記有機材料を液晶中で高分子化することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 2 4】 第 1 の基板と透明な第 2 の基板とこれらに挟まれた液晶層とカラーフィルター層とを有する液晶表示装置の製造方法において、

5 前記カラーフィルター層を前記第 1 の基板上に形成し、

前記液晶層を前記カラーフィルター層と前記第 2 の基板との間に形成し、

前記カラーフィルター層下の前記第 1 の基板上に、複数の走査信号電極と、それらにマトリクス状に交差する複数の映像信号電極と、これらの電極のそれぞれの交点に対応して形成された複数の薄膜トランジスタと形成し、

10 前記複数の走査信号電極および映像信号電極で囲まれるそれぞれの領域で少なくとも 1 つの画素を構成し、

それぞれの画素には共通電極配線により複数の画素に渡って接続されて基準電位を与える共通電極と、対応する薄膜トランジスタに接続されて前記画素領域において前記共通電極に対向配置する画素電極とを形成し、

15 前記共通電極および前記画素電極を、前記カラーフィルター層と前記液晶層との間に配置し、かつ、前記共通電極と前記画素電極は透明な絶縁物からなる層間分離膜を介して互いに異なった層に配置し、

前記液晶は、前記共通電極と前記画素電極との間に印加される電圧が印加されていないときは、第 1 の基板に対してほぼ垂直に配向している状態に形成し、

20 光学的に負の補償フィルムと光学的に正の補償フィルムを第 1 または第 2 の基板と偏光板との間に形成し、前記補償フィルムに電圧を印加した際に液晶が倒れる 2 方向に沿ってラビング方法でプレチルト角を形成する

ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 2 5】 第 1 の基板と透明な第 2 の基板とこれらに挟まれた液晶層とカラーフィルター層とを有する液晶表示装置の製造方法において、

25 前記カラーフィルター層を前記第 1 の基板上に形成し、

前記液晶層を前記カラーフィルター層と前記第 2 の基板との間に形成し、

前記カラーフィルター層下の前記第 1 の基板上に、複数の走査信号電極と、それらにマト

リクス状に交差する複数の映像信号電極と、これらの電極のそれぞれの交点に対応して形成

された複数の薄膜トランジスタと形成し、

前記複数の走査信号電極および映像信号電極で囲まれるそれぞれの領域で少なくとも 1 つの画素を構成し、

それぞれの画素には共通電極配線により複数の画素に渡って接続されて基準電位を与える共通電極と、対応する薄膜トランジスタに接続されて前記画素領域において前記共通電極
5 に対向配置する画素電極とを形成し、

前記共通電極および前記画素電極を、前記カラーフィルター層と前記液晶層との間に配置し、かつ、前記共通電極と前記画素電極は透明な絶縁物からなる層間分離膜を介して互いに異なった層に配置し、

10 前記液晶は、前記共通電極と前記画素電極との間に印加される電圧が印加されていないときは、第 1 の基板に対してほぼ垂直に配向している状態に形成し、

光学的に負の補償フィルムと光学的に正の補償フィルムを第 1 または第 2 の基板と偏光板との間に形成し、前記補償フィルムに電圧を印加した際に液晶が倒れるどちらか一方の方向にラビング方法でプレチルト角を形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

15 【請求項 26】 第 1 の基板と透明な第 2 の基板とこれらに挟まれた液晶層とカラーフィルター層とを有する液晶表示装置の製造方法において、

前記カラーフィルター層を前記第 1 の基板上に形成し、

前記液晶層を前記カラーフィルター層と前記第 2 の基板との間に形成し、

前記カラーフィルター層下の前記第 1 の基板上に、複数の走査信号電極と、それらにマト
20 リクス状に交差する複数の映像信号電極と、これらの電極のそれぞれの交点に対応して形成された複数の薄膜トランジスタと形成し、

前記複数の走査信号電極および映像信号電極で囲まれるそれぞれの領域で少なくとも 1 つの画素を構成し、

それぞれの画素には共通電極配線により複数の画素に渡って接続されて基準電位を与える
25 共通電極と、対応する薄膜トランジスタに接続されて前記画素領域において前記共通電極に対向配置する画素電極とを形成し、

前記共通電極および前記画素電極を、前記カラーフィルター層と前記液晶層との間に配置し、かつ、前記共通電極と前記画素電極は透明な絶縁物からなる層間分離膜を介して互いに異なった層に配置し、

前記液晶は、前記共通電極と前記画素電極との間に印加される電圧が印加されていないときは、第 1 の基板に対してほぼ垂直に配向している状態に形成し、

光学的に負の補償フィルムと光学的に正の補償フィルムを第 1 または第 2 の基板と偏光板との間に形成し、前記補償フィルムに電圧を印加した際に液晶が倒れる 2 方向に沿って光

5 照射によりプレチルト角を形成する

ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 27】 第 1 の基板と透明な第 2 の基板とこれらに挟まれた液晶層とカラーフ
ィルター層とを有する液晶表示装置の製造方法において、

前記カラーフィルター層を前記第 1 の基板上に形成し、

10 前記液晶層を前記カラーフィルター層と前記第 2 の基板との間に形成し、

前記カラーフィルター層下の前記第 1 の基板上に、複数の走査信号電極と、それらにマト
リクス状に交差する複数の映像信号電極と、これらの電極のそれぞれの交点に対応して形成
された複数の薄膜トランジスタと形成し、

前記複数の走査信号電極および映像信号電極で囲まれるそれぞれの領域で少なくとも 1
15 つの画素を構成し、

それぞれの画素には共通電極配線により複数の画素に渡って接続されて基準電位を与え
る共通電極と、対応する薄膜トランジスタに接続されて前記画素領域において前記共通電極
に対向配置する画素電極とを形成し、

前記共通電極および前記画素電極を、前記カラーフィルター層と前記液晶層との間に配置
20 し、かつ、前記共通電極と前記画素電極は透明な絶縁物からなる層間分離膜を介して互いに
異なった層に配置し、

前記液晶は、前記共通電極と前記画素電極との間に印加される電圧が印加されていないと
きは、第 1 の基板に対してほぼ垂直に配向している状態に形成し、光学的に負の補償フィル
ムと光学的に正の補償フィルムを第 1 または第 2 の基板と偏光板との間に形成し、前記補償
25 フィルムに電圧を印加した際に液晶が倒れるどちらか一方の方向に光照射によりプレチル
ト角を形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 28】 請求項 26 記載の液晶表示装置の製造方法において、

前記プレチルト角の形成における光照射は、前記補償フィルム面に対して斜めから行うこ
とを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 29】 請求項 28 記載の液晶表示装置の製造方法において、前記プレチルト角の形成における光照射は、偏光を前記補償フィルム面に対して斜めから照射することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

5 【請求項 30】 請求項 27 記載の液晶表示装置の製造方法において、前記プレチルト角の形成における光照射は、前記補償フィルム面に対して斜めから行うことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 31】 請求項 28 記載の液晶表示装置の製造方法において、前記プレチルト角の形成における光照射は、偏光を前記補償フィルム面に対して斜めから照射することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

10 【請求項 32】 透明基板上に薄膜トランジスタを形成する工程と、
その薄膜トランジスタを保護するパッシベーション膜を形成する工程と、
複数の感光性カラーレジストを順次に塗布、露光、現像、焼成してカラーフィルターを形成する工程と、
共通電極を形成する工程と、
15 透明性の絶縁膜からなる層間分離膜を形成する工程と、
画素電極を形成する工程と
を含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 33】 透明基板上に薄膜トランジスタを形成する工程と、
その薄膜トランジスタを保護するパッシベーション膜を形成する工程と、
20 複数の感光性カラーレジストを順次に塗布、露光、現像、焼成してカラーフィルターを形成する工程と、
そのカラーフィルターを保護するオーバーコート膜を形成する工程と、
共通電極を形成する工程と、
透明性の絶縁膜からなる層間分離膜を形成する工程と、
25 画素電極を形成する工程と、を含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 34】 請求項 3 記載の液晶表示装置において、
前記共通電極は前記画素を囲うように格子状に形成され、
前記画素電極は前記画素の中を横切るように配置され、
前記共通電極が前記共通電極配線の一部を共用して形成されたことを特徴とする液晶表

示装置。

【請求項 3 5】 請求項 3 記載の液晶表示装置において、

前記共通電極および画素電極が、前記画素内に複数組配置されたことを特徴とする液晶表示装置。

5 【請求項 3 6】 請求項 4 記載の液晶表示装置において、

前記共通電極は前記画素を囲うように格子状に形成され、

前記画素電極は前記画素の中を横切るように配置され、

前記共通電極が前記共通電極配線の一部を共用して形成されたことを特徴とする液晶表示装置。

10 【請求項 3 7】 請求項 4 記載の液晶表示装置において、

前記共通電極および画素電極が、前記画素内に複数組配置されたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3 8】 請求項 5 記載の液晶表示装置において、

前記共通電極は前記画素を囲うように格子状に形成され、

15 前記画素電極は前記画素の中を横切るように配置され、

前記共通電極が前記共通電極配線の一部を共用して形成されたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3 9】 請求項 5 記載の液晶表示装置において、

20 前記共通電極および画素電極が、前記画素内に複数組配置されたことを特徴とする液晶表示装置。

要約書

カラーフィルタを備えた第1の基板101と、液晶層を140を介した第2の基板131とからなる液晶表示装置において、色むらの発生を抑制するために、第1の基板上101に形成した薄膜トランジスタの保護膜108上に、カラーフィルター層110が遮光部111で区切られて配置され、この上に、共通電極103が配置され、かつ、オーバーコート層（層間分離膜）112に形成されたスルーホールを介し、ソース電極107に接続する画素電極114が配置される。また、前記カラーフィルター層110下の前記第1の基板上には、複数の走査信号電極と、それらにマトリクス状に交差する複数の映像信号電極と、これらの電極のそれぞれの交点に対応して形成された複数の前記薄膜トランジスタとを有し、それぞれの画素には共通電極配線により複数の画素に渡って接続されて基準電位を与える共通電極103と、対応する薄膜トランジスタに接続されて前記画素領域において前記共通電極に対向して配置された画素電極114とを有している。